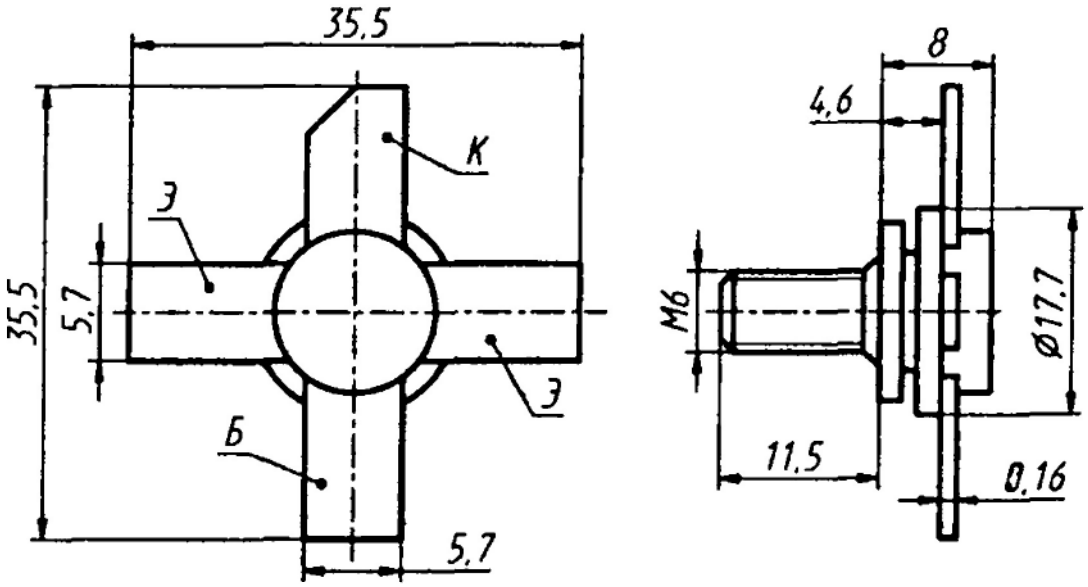
2Т964А

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *n-p-n* усилительный линейный. Предназначен для применения в широкополосных усилителях мощности в диапазоне 30...80 МГц при напряжении питания 40 В. Выпускается в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами и монтажным винтом. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 10 г.

2Т964А



Электрические параметры

Выходная мощность на частоте f = 80 МГц при $U_п$ = 40 В, не менее	150 Вт
Коэффициент усиления по мощности при $P_{вых\ (по)}$ = 150 Вт, $U_п$ = 40 В, f = 80 МГц	5...6*...8*
Коэффициент полезного действия коллектора при $P_{вых\ (по)}$ = 150 Вт, $U_п$ = 40 В, f = 80 МГц	40...50*...60*%
Коэффициент комбинационных составляющих 3-го и 5-го порядков при $P_{вых\ (по)}$ = 150 Вт, $U_п$ = 40 В, f = 80 МГц	−33*...−30*...−27 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб}$ = 10 В, $I_к$ = 5 А	10...15*...50*
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{кэ}$ = 20 В, $I_к$ = 2 А, f = 30 МГц	5...7*...10*
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб\ 0}$ = 40 В	220*...240*...290 пФ

ООО компания "Электроника и связь"
тел. (473) 277-14-34, 277-35-34
www.eandc.ru

Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб}$ = 4 В, не более	4000* пФ
Индуктивность выводов:	
коллекторного	1,6* нГн
базового	1,9* нГн
эмиттерного	2,8* нГн
Входное полное сопротивление при $P_{вых\ (по)}$ = 150 Вт, f = 80 МГц	0,78 + + j0,62* Ом
Последовательное активное сопротивление эмиттера	0,15 Ом
Обратный ток коллектора при $U_{кб\ 0}$ = 80 В, не более:	
T = +25 °С	100 мА
T = −60 и +125 °С	150 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб\ 0}$ = 4 В, не более	500 мА

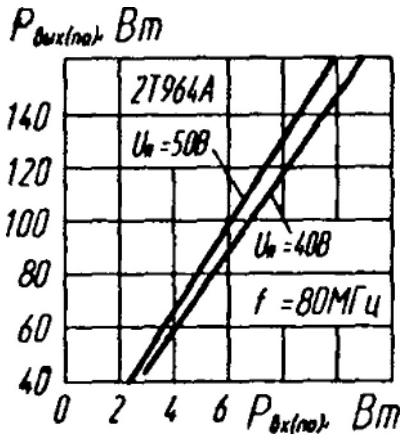
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{эб}$ = 10 Ом	80 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	4 В
Постоянный ток коллектора	10 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
$T_к \leqslant$ +50 °С	200 Вт
$T_к$ = +125 °С	100 Вт
Средняя рассеиваемая мощность в динамическом режиме:	
$T_к \leqslant$ +50 °С	200 Вт
$T_к$ = +125 °С	100 Вт
Входная мощность	40 Вт
КСВН коллекторной цепи при $P_{вых}$ = 100 Вт, любой фазе рассогласования в течение 1 с	30
Тепловое сопротивление переход—корпус	0,75 °С/Вт
Температура p-n перехода	+200 °С
Температура окружающей среды	−60... $T_к$ = = +125 °С

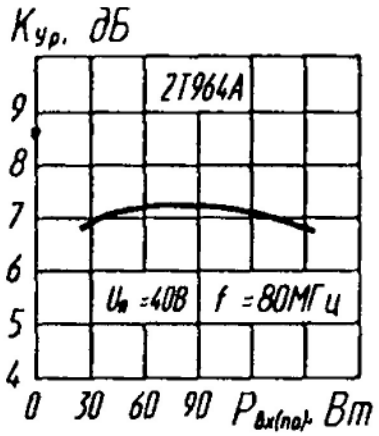
Допускается работа транзистора в диапазоне частот 1... 30 МГц и свыше 80 МГц. При этом параметры $P_{вых}$, $K_{у,\ р}$, $\eta_к$, M_3 и M_5 не регламентируются.

ООО компания "Электроника и связь"
тел. (473) 277-14-34, 277-35-34
www.eandc.ru

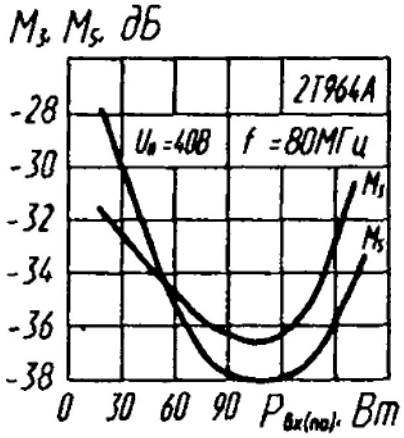
Пайка выводов допускается не ближе 2 мм при температуре не выше +260 °С в течение не более 8 с и ближе 2 мм при температуре не выше +150 °С.



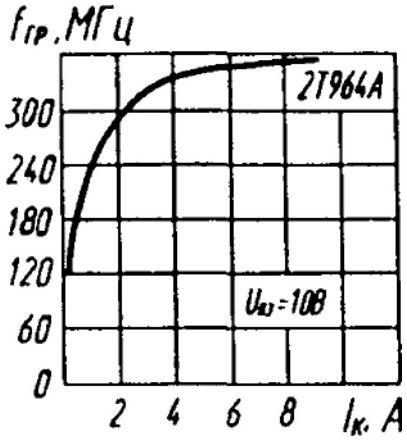
Зависимости выходной мощности от входной мощности



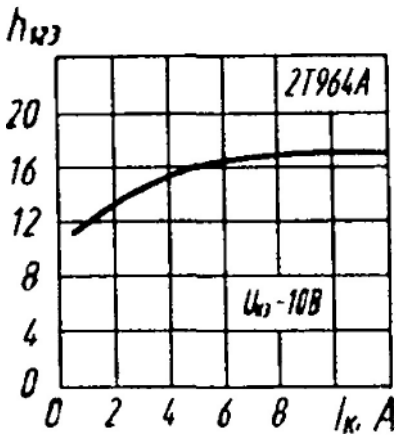
Зависимость коэффициента усиления по мощности от входной мощности



Зависимости коэффициента комбинационной составляющей 3-го и 5-го порядков от входной мощности



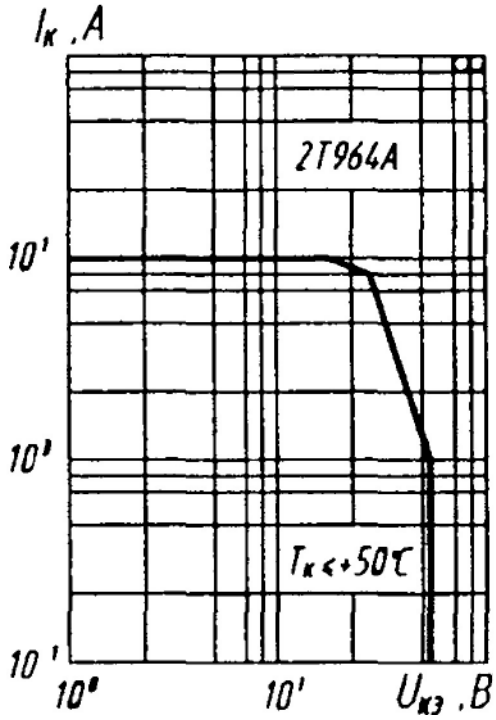
Зависимость граничной частоты от тока коллектора



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора

ООО компания "Электроника и связь"
тел. (473) 277-14-34, 277-35-34
www.eandc.ru

Область максимальных режимов



ООО компания "Электроника и связь"
тел. (473) 277-14-34, 277-35-34
www.eandc.ru